**Карфул Ризек. Поведение глубоких центров в GaAs при лазерном облучении барьеров шоттки : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Гос. техн. ун-т.- Санкт-Петербург, 1992.- 16 с.: ил. РГБ ОД, 9 92-2/2155-4**